实验名称 光刻工艺

一、实验目的

- 1.掌握光刻工艺流程,以及参数设置对光刻效果影响
- 2.制作分辨率板
- 3、制作相位光栅并进行光栅常数的测量

二、实验预习

- 1. 光刻的基本流程:
 - 1.前处理:主要是清洁基片,改善基片的表面活性提高粘接力
 - 2.旋胺:匀胶+甩胶
 - 3.软烘烤:加热固化使光刻胶和基板结合牢阁图
 - 平.对准的曝光:将图案到胜到基板上.
 - 5.溶剂显影:去除刻出部分,显示图案
 - 6、微观检测:显微镜观测刻蚀精度 检验图案
- 2. 已知光源波长,如何通过衍射图形计算光栅的常数? 测出第一级干涉条纹偏离中心的角度 0 利用 dsin 0= k入(K-1) 可算出d.

三、实验现象及数据记录

1.分辨率板和光栅的图片

2.光栅到白板的距离为2.75m; 激光波长为650nm

		1-				
光栅		+1	-1	1级衍射角	光栅常数	
1 1 1	7 100	1.65	-228	4.92	758 pm. 15.01	bum
2		1.43	-1.45	3.63.	10.27 pm 20.5	Yun.
3	18	1.35	-4.62	7.54	4.95 pm 9.90 pm	LM .
4		8.25	3.74	15.29	4. 1 1 1 3 Jun 4 9 Jun 4 Jun 4 9 J	. דרין

(1) 福建各级。至很有效处域就性特美人种各种食

教师	姓名
签字	外產

四、实验结论及现象分析

明显观察到光刻出的分辨率板以及光栅 说明光刻工艺效果显著 可以通过形衍射条纹算出每个光栅的光栅常数 及其一级纷射角

五、讨论问题

- 1. 光刻中曝光的方式有哪三种? 并简单说明其优缺点。
- 2. 根据光刻胶的应用,请列举其需要具备哪些特性。
- 1. ①接触式曝光 优点:精度高,成本低 缺点:容易产生残留图案,掩*膜与基片接触易损坏
 - ②放影式曝光(非接触式曝光) 优点:掩膜/基片不易损坏 缺点:容易产生模糊图案,曝光时间要求高
 - ③投影式曝光 优点:更高分辨率,更大曝光面积 缺点:设备成本高
- 2.①具有良好的光刻性能
 - ②有可控的成膜厚度和表面平整性
 - ③有良好的选择性和耐蚀刻性
 - 田有抗污染性
 - 写有稳定性

